

## 유전체주의 전자장 산란 해석

正會員 朴 東 熙\* 正會員 金 正 祺\*

### An Analysis of Electromagnetic Field Scattering for the Dielectric Cylinders

Dong Hee PARK\*, Jung Ki KIM\* Regular Members

#### 要 約

임의 단면을 갖는 도체 및 유전체주로 비추어진 TMz 산란 특성은 경계요소법으로 해석하였다. 경계요소 방정식은 Maxwell 방정식, 가중잔차 또는 Green 정리, 그리고 경계조건에 의해서 구성된다. 이때 경계상에서의 미지 표면장은 경계요소 접근 방정식으로 계산된다. 경계상에서 표면장이 구해지므로 무한공간에서 산란된 장과 산란폭은 쉽게 구할 수 있다. 해석된 예로써 완전도체 원형과 타원형 원통주, 그리고 유전체 원형과 타원형 원통주로부터의 평면파 산란을 수치적으로 해석하였다. 컴퓨터 프로그램은 2차요소(고차경계요소)와 Gaussian 구적법을 사용하여 향상시켰다.

#### ABSTRACT

The scattering property of TMz illuminated perfectly conducting and dielectric cylinders of arbitrary cross section are analyzed by the boundary element techniques. The boundary element equations are formulated via Maxwell's equations, weighted residual or Green's theorem, and the boundary conditions. The unknown surface fields on the boundaries are then calculated by the boundary element integral equations. Once the surface fields are found, the scattered fields in far-zone and scattering widths(SW) are readily determined. As examples, plane wave scattering from a perfectly conducting circular and elliptic cylinders, a dielectric circular and elliptic cylinders are numerically analyzed. A general computer program has been developed using the quadratic elements(higher order boundary elements) and the Gaussian quadrature.

#### I. 서 론

전자장 개방영역문제의 해석적 방법은 지난 수년

에 걸쳐 많은 연구가 진행되어 왔다. 임의의 두개의 서로 다른 매질사이에서 경계상의 표면전자장을 포함하도록 하는 방법은 Helmholtz방정식과 Green정리 및 잔차법에 의한 모멘트법을 사용하는 방법이 연구되었다. 이는 모두 표면직분방정식에 의한 해석으로서 경계조건을 만족하는 급수진개함수인 기저함수의 선택에 따라서 해의 정확도에 수렴하게 된다<sup>[1][2]</sup>.

\*中央大學校 電子工學科  
Dept. of Elec. Eng. Chungang Univ.  
論文番號: 92-19 (1991. 11. 15)

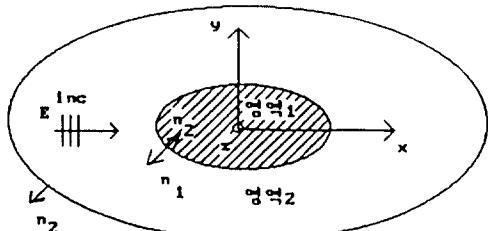
[3]

본 논문에서는 유한요소법의 요소분할법을 표면적 분명장식에 적용하여 부분적인 요소영역에서 요소의 절점좌표와 합수값에 의해 표현되는 2차원상한수를 사용한 경계요소법을 전자장산란 해석에 사용하였다. 자유공간에 놓인 임의의 형태를 갖는 도체 또는 유전체에 대한 무영역의 경계작문식에 관한 Cauchy주치작문을 Gaussian구직법으로 해석하여 각각의 영역에서 만족한 행렬을 경계조건에 의해 조합하게된다. 관측점과 원진점이 동일 위치에 놓여있는 경우에 있어서 Green함수 특이점을 제거하기 위해 특이점의 주위로 반경  $\delta \rightarrow 0$ 인 직분경로를 선택하면서 직분명장식내의 Hankel함수를 급수전개식으로 변환하게되는 번거로움이 되따르게 된다. 그러나 요소의 값이가 과장에 비하여 충분히 작을 경우에  $\delta \rightarrow 0$ 에 대한 의미로서 Gaussian구직법을 직분명장식에 직접 적용하여도 Cauchy주치작문해와 같은 오차가 없었다. 따라서 본 논문에서는 해석적 편의상에 맞추어 직접적으로 Gaussian구직법을 사용하였다.

최종수식에 대한 타당성과 유통성을 보이기 위하여 수치계산된 결과는 원통주의 반경이 각각 다른 경우에 대한 2차원 단면원통주의 산란을 계산하여 Balanis<sup>6</sup>와 비교하였다. 높임한 그림의 유전체 ( $\epsilon_r = 2.0$ )인 경우에 대해서도 산란을 구하였으며, 전자장산란의 다중매질문제로서 임의의 기울기는 원형 및 타원원통형 원진도체와 유전체에 대한 산란을 관측점의 각도 및 전진번호에 따라서 해석하였다.

## II. 전자계의 경계요소식

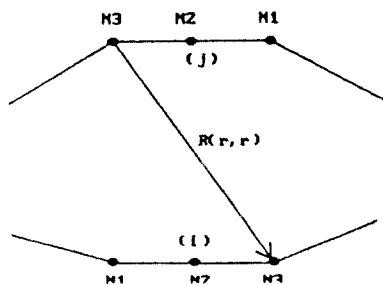
<그림 1>에서와 같이 임의의 형태를 갖는 2차원 원통형 유전체주 문제에 대한 외부 전자계의 예로서 2매질로 이루어진 폐영역을 고려한다.



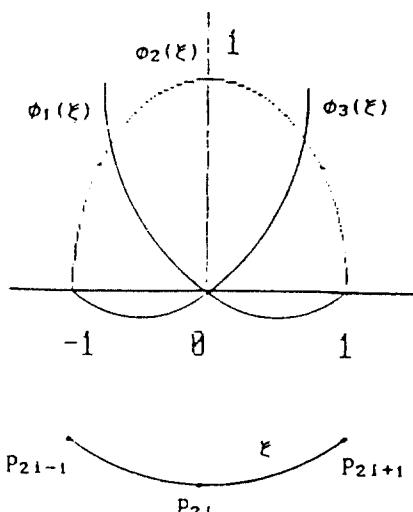
<그림 1> 유전체를 포함한 2차원 폐영역

영역1은 원통형 유전체주의 2차원영역이고, 영역2는 영역1을 제외한 나머지 2차원 외부영역을 나타낸다. 전자장 성분에 대해 내부영역(영역1)에서 또는 외부영역(영역2)에서 TM mode인 경우  $U = Ez$  그리고 TE mode인 경우  $U = Hz$ 로 놓는다. 전자장산란 문제를 해석하기 위해  $Z$ 축 방향으로 단일한 매질 문제에 대한 무경계장을 고려한다. 입사파는  $E$ 분수를 고려했으며, 원통주  $Z$ 축에 주직으로 입사하고 시간  $t$ 에  $\text{EXP}(j\omega t)$ 을 가정한다. 내부영역에서 만족되는 경계분식은 다음과 같다<sup>[3][4]</sup>.

$$\text{C}U + \oint_{\Gamma} G_1 \frac{\partial U}{\partial n} dI = \oint_{\Gamma} G_2 \frac{\partial U}{\partial n} dI \quad (1)$$



<그림 2> 2차 요소  $\Delta$ 와 절점  $N_1$ ,  $N_2$  그리고  $N_3$ 과의 관계



<그림 3> 2차원 단위원주와 경계요소

여기서  $C_0$ 는  $(1/\theta/2\pi)$ 이고, 요소의 절점과 관측점은 경계  $\Gamma$ 상에 모두 존재 한다. 각각 영역의 경계  $\Gamma$ 에서 절점이 존재하도록 하며,  $U$ 와  $Q$ 는 경계의 요소로서 2차함수적으로 변화할 경우 다음과 같이 이산화 된다<sup>[3]</sup>.

고차요소(3 절점 2차요소)

$$\begin{aligned} C_0 U_e + \sum_{\substack{j=N_1 \\ j \neq N_2 \\ j \neq N_3}} \int_{\Gamma_j} U Q \frac{d\Gamma}{d\Gamma} + \int_{\Gamma_j-N_1} U Q \frac{d\Gamma}{d\Gamma} + \int_{\Gamma_j-N_2} U Q \frac{d\Gamma}{d\Gamma} + \int_{\Gamma_j-N_3} U Q \frac{d\Gamma}{d\Gamma} \\ + \sum_{\substack{j=N_1 \\ j \neq N_2 \\ j \neq N_3}} \int_{\Gamma_j} Q U \frac{d\Gamma}{d\Gamma} + \int_{\Gamma_j-N_1} Q U \frac{d\Gamma}{d\Gamma} + \int_{\Gamma_j-N_2} Q U \frac{d\Gamma}{d\Gamma} + \int_{\Gamma_j-N_3} Q U \frac{d\Gamma}{d\Gamma} \end{aligned} \quad (2)$$

식(2)에서  $N_1$ ,  $N_2$  그리고  $N_3$ 는 요소에 이웃한 절점과 요소중앙에서의 절점을 각각 나타낸다.

식(2)을 임의의 대표요소에 대한 행렬식으로 나타내면 다음과 같다.

$$C_0 U_e + \sum_{j=1}^3 [h_1, h_2, h_3] \begin{Bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix}_e = \sum_{j=1}^3 [g_1, g_2, g_3] \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix}_e \quad (3)$$

식(3)에서  $n$ 은 요소의 종수이고  $U_1$ ,  $U_2$ , 및  $U_3$ 과  $Q_1$ ,  $Q_2$  및  $Q_3$ 는  $e$ 번째 대표요소의 3절점에서  $E$ 과  $H$ 파의 전자장값과 그 도함수값을 나타낸다.

식(3)에서 전체절점 및 요소에 대한 행렬식은 다음과 같다.

$$\sum_{i=1}^n H_{ij} U_i = \sum_{i=1}^n G_{ij} Q_i, \quad j=1, 2, \dots, n \quad (4)$$

$$H_{ij} = \begin{cases} h_{N_{j+1}} + h_{N_{j+2}}, & j \neq N_1, N_3 \\ h_{N_{j+1}}, & j \neq N_2 \\ h_{N_{j+1}} + h_{N_{j+2}} + C, & j = N_1, N_3 \\ h_{N_{j+1}} + C, & j = N_2 \end{cases} \quad (5)$$

$$G_{ij} = \begin{cases} g_{N_{j+1}} + g_{N_{j+2}}, & j \neq N_1, N_3 \\ g_{N_2}, & j = N_2 \end{cases} \quad (6)$$

식(4)에 의한 최종 요소행렬은 다음과 같다.

$$[H_e][U_e] = [G_e][Q_e] \quad \text{영역1} \quad (7)$$

TM mode인 경우 영역1에서 총전계를 정의하여 대표함수  $U_e$  및  $Q_e$ 로서 다음과 같이 나타낸다.

$$\begin{aligned} U_e &= U_{e, sc} + U_{e, in} \\ Q_e &= Q_{e, sc} + Q_{e, in} \end{aligned} \quad (8)$$

여기서 침자  $e$ 는 영역1에서 정의된 성분을 의미하고, 그리고  $sc$ 와  $in$ 은 각각 산란과 임사를 의미한다. 영역2에서 지배방정식은 TM mode인 경우 경계에서 산란전 세  $E$ 파와 사용하도록 정의한다. 외부 영역은 무경계장이 적용되는 영역으로서 다음과 같이 유도된다.

$$C_0 U_e - \oint_{\Gamma} \frac{\partial G_e}{\partial n} U_e d\Gamma = \oint_{\Gamma} G_e \frac{\partial U_e}{\partial n} d\Gamma \quad (9)$$

$C_0$ 는  $(1+\theta/2\pi)$ 이고, 기준 범선방향을 경계  $\Gamma$ 에서 밖으로 향하도록 하였으므로 외부영역에서 만족된 적분방정식의 무호는 내부 적분방정식의 무호에 반대 무호를 갖는다. 또한 요소의 절점과 관측점은 경계  $\Gamma$ 에 모두 존재한다.

부사조건은 임사파에 적용될 수 없으므로 경계요소식이 단지 유전체 경계면  $\Gamma$ 에서 적용되므로  $U_{e, in}$ 의 적분방은 삭제되어 순수 산란장만이 존재한다. 식(2)와 동일한 방법으로 식(9)의 요소행렬식은 다음과 같다.

$$[H_e][U_e] = [G_e][Q_e] \quad \text{영역2} \quad (10)$$

여기서 침자  $e$ 는 영역2에서 정의된 성분을 의미하고, 그리고 경계  $\Gamma$ 에서 다음과 같은 경계조건이 만족된다.

$$\begin{aligned} U_{e, sc} &= U_{e, sc} = U_{sc} \\ Q_{e, sc} &= Q_{e, sc} = Q_{sc} \end{aligned} \quad (11)$$

TM mode인 경우 임사파는 다음과 같다.

$$U_e^{inc} U_{e, in} = E_{x0, in} \exp(-jkR) \quad (12)$$

임사파의 좌표는 〈그림 1.〉에서처럼 임사방향을 선택한다.

따라서 수직도함수에 의한 식은 다음과 같이 유도된다.

$$Q_{in} = \frac{\partial U_{in}}{\partial n} = jkni \cdot \hat{n}_R U_{in}$$

$$\hat{n}_R = \hat{n}_x + \hat{n}_y$$

식(13)을 행렬식으로 표현하면 다음과 같다.

$$Q_{in} = B_R U_{in}$$

여기서  $B_R = jkni \cdot \hat{n}_R$ 이 된다.

식(7), (10) 그리고 식(14)에 의해 다음과 같은 전자영역(1+2)에 대한 행렬식이 구성된다.

$$\begin{bmatrix} H_1 G_1 \\ H_2 G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{sc} \\ Q_{sc} \end{bmatrix} = -U_{in} \begin{bmatrix} H_1 G_1 B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

식(15)에 의해 산란장은 입사파가 세시된 경계  $\Gamma$ 상에서 계산된다. 무한한 자유공간에서 산란된 전자장을 구하기 위해서는 영역2에서 반죽되는 영역적 분식(16)에 식(15)에서 얻어진 표면전자장값을 대입하여 무한 공간에서 산란전자장을 해석한다.

$$U_{sc}^* = \int_{\Gamma} \frac{\partial G_{sc}}{\partial n} U_{sc} d\Gamma - \int_{\Gamma} G_{sc} \frac{\partial U_{sc}}{\partial n} d\Gamma$$

따라서 RCS는 다음과 같이 구한다.<sup>[18]</sup>

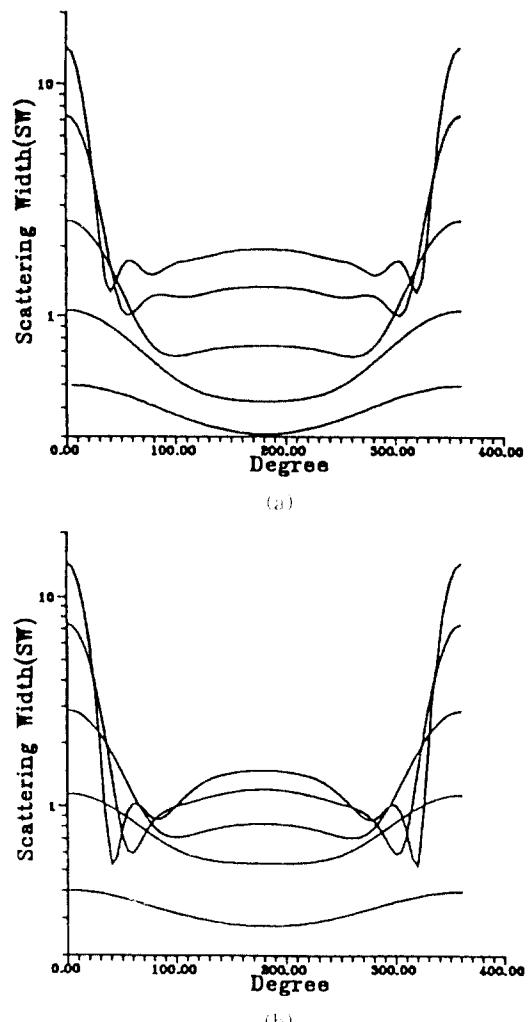
$$S\sigma(\phi) = \lim_{r \rightarrow \infty} 2\pi r \left| \frac{\vec{E}_z(r)}{\vec{E}_z(r)} \right|^2$$

유사한 방법으로 TE<sub>z</sub> 입사평면파에 대한 산란전자장을 해석할 수 있다.

### III. 결과 및 고찰

원형 및 타원형인 완전도체와 유전체로부터의 평면전자장 산란파는 다중문제를 갖는 경계요소법으로 고찰하였다. 입사파는 E<sub>x</sub>방향의 X축 방향에서 X축을 따라 진행 한다고 가정한다. 완전도체원통주의 2차원적 단면에 대해 각각의 반경변화에 따른 산란폭이 결과는 그림 4.)에 나타내었으며, (a)는 해석적 방법에 의해 계산된 결과이고, (b)는 본 논문에서 제시된 경계요소법인 수치적 방법의 결과를 나타낸다. (b)의 그림에서 산란장의 무한 기라지는  $100\lambda$  이

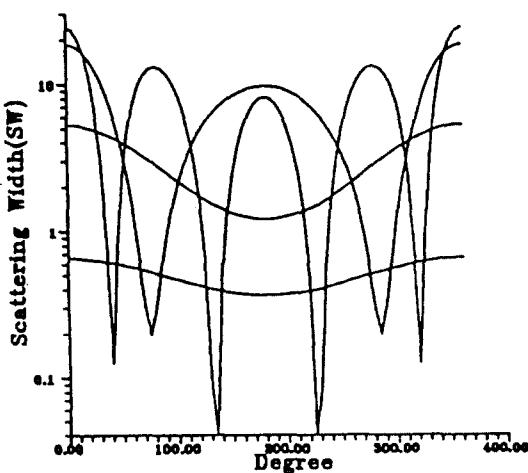
상에서 관측점을 택하였다. 경계상의 전체 절점수는 72개로 선택했고 총 요소수는 36개로 해석하였다.



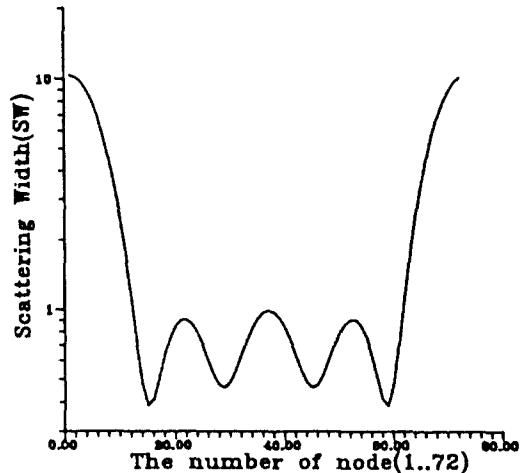
〈그림 4.〉 원통형 완전도체(  $\sigma \rightarrow \infty$ ,  $\epsilon_r=1$ )의 2차원적 TM<sub>z</sub> bistatic 산란폭(0° ~ 360°)  
a) 해석적 방법 b) 수치적 방법(BEM)

〈그림 4.〉에서 해석된 산란체와 같은 단위를 갖고 유전율  $\epsilon_r=2.0$ 인 유전체주에 대한 산란폭의 수치적 결과는 〈그림 5.〉에서 나타내었다.

완전도체( $\sigma \rightarrow \infty$ )인 경우  $a=b=1$ 인 원통주와 타원형( $a=3$ ,  $b=1$ )원통주인 경우에 대하여 그리고 같은 단위를 갖는 각각의 유전체주에 대한 2차원적

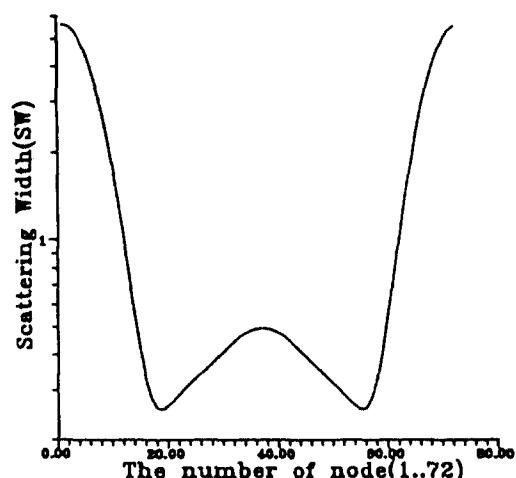


〈그림 5.〉 원통형 유전체주( $\epsilon_r=2.0$ )의 2차원적 TM<sub>z</sub> bistatic 산란폭(0° .. 360°)

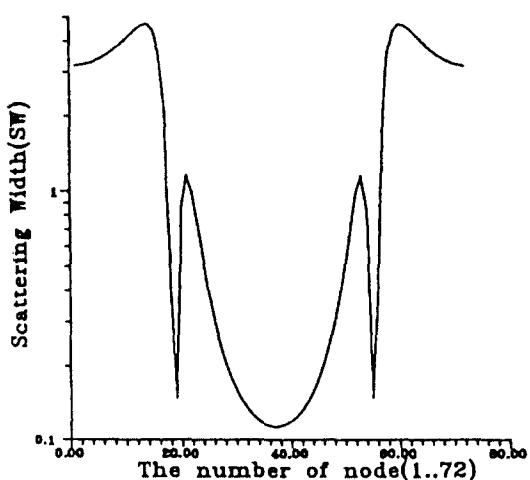


(b)

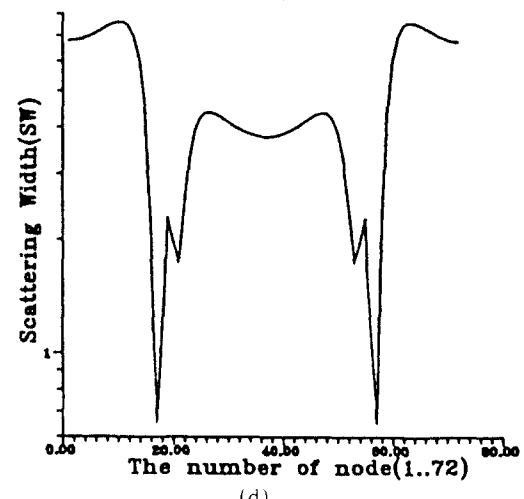
TM<sub>z</sub> bistatic 산란폭의 수치적 결과는 총 절점수 72개에 대한 절점번호 순서에 따라 〈그림 6.〉에 나타내었다.



〈그림 6.〉 완전도체( $\epsilon_r=1.0$ ) 및 유전체( $\epsilon_r=4.0$ )인 경우 원형( $a=b=1$ )과 타원형( $a=3, b=1$ )원통주의 원주 절점에 의한 2차원적 TM<sub>z</sub> bistatic 산란폭 ( $\sigma/\pi(ab)^{1/2}$ ) 절점수(1..72)  
 (a) 완전도체 원형원통주( $\mu_r=1.0, \epsilon_r=1.0$ )  
 (b) 유전체 원형원통주( $\mu_r=1.0, \epsilon_r=4.0$ )  
 (c) 완전도체 타원형원통주( $\mu_r=1.0, \epsilon_r=1.0$ )  
 (d) 유전체 타원형원통주( $\mu_r=1.0, \epsilon_r=4.0$ )



(c)



(d)

## IV. 결 론

본 논문은 경계요소법에 의한 개방영역문제 및 다중매질문제에 대한 전사장 해석방법으로서 Green 함수의 특이점을 갖는 경우에 Cauchy 주치식문 자세에 Gaussian 적분법과 2차형 상환수를 적용하여 계산된 수치적 결과와 해석적 결과를 비교하여 타당성을 입증하였다. 본 방법의 응용으로서 여러 가지를 갖는 완전도체 및 유전체에 대해 평면과 전사장 산란률을 해석하였다. 2차형 상환수 이상의 고차형 상환수를 이용한 2중 이상의 다중매질 문제로의 전사장 산란인구의 확장이 요구된다.

## References

1. B.H.Mcdonald and A.Wexler, "Finite Element Solution of Unbounded Field Problems," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol.MTT-20, pp.841-847, Dec. 1972
2. S.Washizu and I.Fukai and M.Suzuki, "Extension of Finite Element Method to Unbounded Field Problems" Electron.Lett., Vol.15, pp. 772-774, Nov.1979
3. TE Kao Wu and Leonard L.Tsai, "Scattering by Arbitrary cross-sectioned Layered Lossy Dielectric Cylinders," IEEE trans. Antennas Propagat., Vol.25, pp.518-524, July 1977
4. Ken'ichiro Yashiro and Sumio Ohkawa, "Boundary Element Method for Electromagnetic Scattering from Cylinders," IEEE Trans. Antennas Propagat., Vol.33, pp.383-389, April 1985
5. C.A.Brebbia and S.Walker, Boundary Element Techniques in Engineering, London : Butterworth, 1980
6. C.A.Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley & Sons, 1989, ch.11
7. J.M.Jin and V.V.Liepa, "Application of Hybrid Finite Element Method to Electromagnetic Scattering from Coated Cylinders", IEEE Trans. Antennas Propagat., Vol.36, pp.50-54, Jan. 1988
8. Ichirou Toyoda, Masanori Matsuhara, and Nobutaki Kumagai, "Extended Integral Equation Formulation for Scattering Problems from a Cylindrical Scatterer", IEEE Trans. Antennas Propagat., Vol.36, pp.1580-1586, Nov.1988



朴東熙(Dong Hee PARK) 正會員  
 1959年8月6日生  
 1985年2月：清州大學校電子工學  
 科卒業  
 1987年2月：中央大學校 大學院  
 電子工學科 (工學碩士)  
 1988年3月～現在：中央大學校大  
 學院 電子工學科 博士過程



金正祺(Jung Ki KIM) 正會員  
 1942年5月5日生  
 1965年2月：延世大學校電氣工學  
 科卒業  
 1969年2月：延世大學校大學院電  
 氣工學科(工學碩士)  
 1975年2月：延世大學校大學院電  
 氣工學科(工學博士)  
 1970年3月～1977年2月：光云工科大學 副教授  
 1977年3月～現在：中央大學校電子工學科 教授  
 1982年12月～1983年12月：美亞理工大學 客員教授